Облікова картка ДіР

Image not found or type unknow

I. Загальні відомості

Державний обліковий номер: 0211U007821

Державний реєстраційний номер: 0111U006568

Особливі позначки: відкрита

Дата реєстрації: 12-10-2011

II. Етап виконання ДіР

Номер етапу: 1

Назва етапу: Розроблення технологічних умов вирощування легова-них нитко-подібних мікро- та нанокристалів Si, Ge, Si1-xGex,Bi методом хімічних газо-транспортних реакцій у закритій галоїдній та від-критій проточній системі

Початок етапу: 08.2011

Закінчення етапу: 09.2011

Вид звітного документа: Проміжний звіт

III. Відомості про виконавця ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Національний університет "Львівська політехніка"

Код за ЄДРПОУ: 02071010

Місцезнаходження:

Форма власності:

Сфера управління: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: (032) 2375089

IV. Відомості про співвиконавців ДіР

V. Відомості про замовника ДіР

Повне найменування юридичної особи (або ПІБ фізичної особи): Державне агентство з питань електронного урядування України

Код за ЄДРПОУ: 37471818

Місцезнаходження: вул. Ділова, 24, м. Київ, Київ, 03150, Україна

Форма власності:

Сфера управління: Кабінет Міністрів України

Ідентифікатор ROR: Не застосовується

Розмір організації:

Телефон: 2071730

VI. Джерела, напрями та обсяги фінансування ДіР

Підстава для проведення ДіР: 34 - договір (замовлення) з центральним органом виконавчої влади, академією наук (головними розпорядниками бюджетних коштів на проведення НДДКР)

Напрям фінансування: 2.5 - програми і проекти у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва

Джерела фінансування

7713 - кошти держбюджету

Код програмної класифікації видатків і кредитування (КПКВК): 5031080

Фактичний обсяг фінансування (тис. грн.): 16.6

VII. Відомості про ДіР

Назва роботи українською:

Розробка технології виготовлення ниткоподібних мікро- та нанокристалів на основі напівпровідників та напівметалів і вивчення їх магніто-транспортних властивостей при пружних деформаціях для створення високочутливих тензо- та термосенсорів

Назва роботи англійською:

The technology development of semiconductor and semimetal micro- and nanocrystal whiskers fabrication and investigation of their magneto-transport properties at elastic strain for creation of tenso- and thermosensors

Реферат українською:

Створення ростової установки для вирощування нанодротин кремнію дозволило вивчити особливості росту ансамблю нанодротин Si методом хімічної газофазової епітаксії у відкритій проточній та закритій бромідній системах для їх подальшого застосування в наноелектронних пристроях.

Реферат англійською:

Creation of equipment for Si nanowire growth allowed to study perculiarities of Si nanowire assembles by chemical vapour deposition mehtod in opened and sealed bromide systems for their futher use in nanoelectrronics devices

Індекс УДК: 681.121./123; 532.57, 531.787

Коди тематичних рубрик: 59.37.33

Керівники роботи

Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Дружинін Анатолій Олександрович

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Ідентифікатор ORCID ID:

Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

Назва НТП українською: Технологія виготовлення ниткоподібних мікро- та нанокристалів на основі напівпровідників та напівметалів для створення високочутливих тензо- та термосенсорів

Назва НТП англійською: The technology of semiconductor and semimetal micro- and nanocrystal whiskers fabrication for creation of tenso- and thermosensors

НТП, яку передбачалося створити:

Причини, через які НТП не було створено:

Отримані результати:

Галузь застосування: 33.20.1 Виробництво контрольно-вимірювальних приладів

Реєстраційний номер картки технології:

Опис НТП: За рахунок проведеного моделювання аксіального та радіального росту нанокриталів кремнію за механізмом пара-рідина-кристал та серії досліджень з вирощування ниткоподібних кристалів кремнію у відкритій проточній системі, підібрані технологічні режими одержання нанокристалів заданого діаметра.

Соціально-економічна спрямованість НТП:

Вплив НТП на довкілля:

Впровадження НТП: Не впроваджено

Практична реалізація НТП

Початок етапу: 2011-2014

Закінчення етапу:

Споживачі продукції: Підприємства електронної техніки

Перспективні ринки: Україна, Польща, країни СНД

Характер співробітництва з інвестором

Потрібний обсяг інвестицій, тис. грн.: 300

Права, що надаються інвестору після завершення роботи:

Наявність бізнес-плану: Ні

Техніко-економічне обгрунтування: Ні

Потенціальний обсяг продажу, тис. грн.: 300

Очікуваний термін окупності (років): 4

Додаткова інформація: За договором

IX. Бібліографічний опис

X. Заключні відомості

Керівник юридичної особи

Піх Зорян Григорович
д. х. н.

Перелік осіб-виконавців

Гарасим Ірина Данилівна

Дружинін Анатолій Олександрович

Нічкало Степан Ігорович

Островський Ігор Петрович

Ховерко Юрій Миколайович

Відповідальний за підготовку облікових документів

Телефон

Реєстратор

Керівник відділу УкрІНТЕІ, що є відповідальним за реєстрацію наукової діяльності

